



СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР  
ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ  
**АВТОРСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО**

№ 1354799

На основании полномочий, предоставленных Правительством СССР, Государственный комитет СССР по делам изобретений и открытий выдал настоящее авторское свидетельство на изобретение:  
**"Сегнетополупроводниковый кристаллический материал"**

Автор (авторы): Тягун Юрий Ильич, Сливка Александр Георгиевич, Герзанич Емельян Иванович, Гурзан Михаил Иванович и Гуранич Павло Павлович

Заявитель: УЖГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Заявка № 4012040 Приоритет изобретения 26 ноября 1985г.  
Зарегистрировано в Государственном реестре изобретений СССР

22 июля 1987г.

Действие авторского свидетельства распространяется на всю территорию Союза ССР.

Председатель Комитета

A handwritten signature in black ink, appearing to be "А.А.А.", written over a faint circular stamp.

Начальник отдела

A handwritten signature in black ink, appearing to be "А.А.А.", written over a faint circular stamp.



СОЮЗ СОВЕТСКИХ  
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ  
РЕСПУБЛИК

(19) SU (111) 1354799 A1

(51)4 С 30 В 29/46 // G 01 L 9/12

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР  
ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ

# ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ Н АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

(21) 4012040/31-26

(22) 26.11.85

(71) Ужгородский государственный университет

(72) Ю.И.Тягур, А.Г.Сливка,  
З.И.Герзанич, М.И.Гурзан  
и П.П.Гуранич

(53) 621.315.592 (088.8)

(56) Авторское свидетельство СССР  
№ 935727, кл. G 01 L 9/02, 1980.

(54) СЕГНЕТОПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

(57) Изобретение относится к сегнетополупроводниковым материалам и приборам, созданным на их основе. Цель изобретения - повышение барьерного

коэффициента диэлектрической проницаемости материала. Сегнето-полупроводниковый материал на основе  $\text{Sn}_{2-x}\text{S}_6$  дополнительно содержит  $\text{Sn}_{2-2x}\text{Se}_6$  и имеет состав, соответствующий формуле  $(\text{Sn}_2\text{P}_x\text{S}_6)_{1-x}(\text{Sn}_2\text{P}_2\text{Se}_6)_x$ , где  $0,05 \leq x < 0,75$ . Кристаллы материала получают методом газотранспортных реакций с транспортирующим агентом  $\text{SnI}_4$ , используя компоненты Sn, P, S, Se в двухзонной печи. Предлагаемый сегнетополупроводниковый материал может быть использован при изготовлении датчиков гидростатического давления, работающих в интервале давлений  $0 < p \leq 0,76$  ГПа, для рабочих температур 208-350 К, 2 ил.

(19) SU (111) 1354799 A1